بسم الله الرحمن الرحيم



دانشكده علوم پايه

## گروه فيزيک

## رساله دکتری

## **بهینه سازی ساختار لیزرهای نیمه رسانای گسیل** سطحی کاواک قائم برای ار تباطات فیبر نوری از: زهرا دانش کفترودی

استاد راهنما: دکتر اسفندیار رجایی اسفند 89

تقديم به خانواده ام

## به نام خدا

حال که با استعانت از ایزد یکتا توفیق تدوین این پایان نامه را یافته ام، بر خود واجب می دانم از تمامی عزیزانی که در طی انجام این پژوهش از یاری و راهنمایی شان بهره مند گشته ام تشکر و قدر دانی نمایم.

در ابتدا صمیمیانه ترین تقدیرها و آرزوها تقدیم به خانواده عزیزم که همواره مشوق و حامی من در روزهای سخت زندگی ام بوده اند.

از استاد راهنمای گرانقدرم آقای دکتر رجایی که با صبوری مرا راهنمایی نموده و در پیشبرد این پایان نامه از هیچ تلاشی دریغ ننموده اند کمال تشکر را دارم.

از جناب آقای دکتر جعفر جهان پناه از دانشگاه تربیت معلم که زحمت بازخوانی ایـن مجموعـه را بـه عهـده داشـتند بسـیار سپاسگزارم.

از داوران محترم آقایان دکتر صابر فرجامی شایسته و دکتر حمید رضا مشایخی استادان دانشگاه گیلان که زحمت تصحیح پایان نامه ام را به عهده داشتند و همچنین نماینده تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر شهروز سعیدی، کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.

در نهایت از تمامی کسانی که در طول این دوره از مصاحبت و همفکری شان استفاده نمودم صمیمانه تشکر می کنم.

چکیده فارسی	ک
چکیدہ انگلیسی	ل
فصل اول	
مقدمه	2
فصل دوم	
بررسی ساختار و عملکرد لیزر نیمه رسانا	
مقدمه	6
1-2 مواد ليزر	6
1-1-2- لیزرهای مبتنی بر  GaAs	7
2-1-2- لیزرهای مبتنی بر InP	8
3-1-2 – لیزرهای مبتنی بر ZnSe	8
4-1-2- لیزرهای مبتنی بر GaN	8
2-2- انواع ليزر	9
2-2 ساختار لیز ر	9
2-3-1 لیزر گسیل لبه ای	9
2-3-2- طراحی ساختار در جهت عمود بر صفحه پیوندگاه	1
2-3-2-1- پيوندگاه همگون	1
-2-2-3-2 بيوندگاه ناهمگون	1

نوانصفح	عن
-3-3- ليزر چاه کوانتومی	-2
-3-4- طراحی ساختار در جهت موازی با صفحه پیوندگاه	-2
-1-4-3- ساختار بهره راهنمایی شده	-2
-3-4-3- ساختار شاخص راهنمایی شده	-2
-3-5-1 ليزر ديود توان بالا	-2
-3-1-5-1 لیزر تک مدی	-2
-3-3-1-1 آرایه چند مدی	-2
-3-2-5-3- میله دیودی	-2
-3-6-1 ليزر گسيل سطحي	-2
-3-6-3- لیزر گسیل سطحی با جفت کننده شبکه توری	-2
-3-7- ليزر آبشارى كوانتومى	-2
-3-1-7-3 لیزر آبشاری کوانتومی نوع n	-2
-2-7-3 ليزر Ge آلائيده شده نوع- p	-2
-4 اساس عملکرد لیزرهای نیمه رسانا	-2
-4-1- گسیل و جذب	-2
-4-4- عناصر اصلي در ليزرهاي نيمه رساناها	-2
-4-2-4- كاواك فابرى پرو	-2
-2-2-4- پيوندگاه p-n "2-2-4-	-2
-4-2-4- ساختارهای ناهمگون دوگانه	-2
-5- بهره آستانه5	-2
-1-5- شرط تشديد	-2
-2-5- شرط بهره	-2
-6- کارایی تابشی	-2
-1-6 کارآیی شیب	-2
-6-2- كارآيى كوانتومى ديفرانسيلى خارجى	-2

وانصا	عنر
6-3-6-نسبت توان خروجي از رخها	-2
7- مشخصه های نور - جریان	-2
-1-7 معادلات آهنگ	-2
-2-7- چگالی جریان آستانه	-2
3-7- مشخصه نور - جریان در عملکرد موج پیوسته	-2
7-3-7- بدون جفت شدگی گسیل خودبخودی به مد لیزر دهی	-2
2-3-7- با جفت شدگی گسیل خودبخودی به مد لیزردهی	-2
8 مشخصه ولتاژ - جريان	-2
9-کاربردهای لیزر نیمه رسانا	9-2
رار کے <sub>مر</sub> ر مر	فص
	• t
رهای کواک کانم کشین شطحی	ىير
دمه	معد
2 ساختار قطعه2	-3
3 انواع VCSEL ها	-3
4 کاربرد VCSELها	-3
VCSEL 5های طول موج بلند	-3
6 پیشرفتهای VCSEL های طول موج بلند	-3
1-6- ادوات مبتنى بر زير لايه GaAS	-3
2-6- ادوات مبتنى بر زير لايه InP	-3
1-2-6 ادواتی با DBR های دی الکتریک	-3
DBR ادواتی با DBR هایWafer- Bonded	-3
6-2-6 - ساختارهای تماماً برآراستی	-3

عنوان	صفحه
فصل چهارم	
مدلسازى	
مقدمه	74
1-4 شبیه سازی الکتریکی	75
1-1-4- باز ترکیب الکترون - حفره	77
1-1-1-4 بازتركيبهاي تابشي	78
2-1-1-4- باز ترکیبهای غیرتابشی	79
2-1-4- توليد حاملها	81
2-2-2-4 فوتون	81
4-1-2-8- يونيزاسيون برخورد	81
4-2-1-4 تونل زنی نوار به نوار	82
4-2- مدل سازی اپتیکی	82
1-2-4- معادلات ماكسول	84
2-2-4- موجهای تخت	84
4-2-4- امواج تخت در فصل مشترکها	85
4-2-4- ساختارهای چندلایه	88
5-2-4- معادلات موج هلم- هولتز	90
4-3- شبيه سازى حرارتى	91
1-3-4- توليد گرما	92
1-1-4- گرمای ژول	92
2-1-3-4- گرمای بازترکیب	92
3-1-3-4 گرمای تامسون	93
4-1-3-4 گرمای جذب اپتیکی	93
2-3-4- مقاومت حرارتی	94
4-4- نوارهای انرژی الکترونی	94

عنوانص	صفحه
1-4-4- موجهای الکترونی	94
5-4- ساختار نوارى الكترونى: روش للم. الم. الم. 5-4	96
1-5-4- مدل دو نواری	96
2-5-4- تاثیرات کرنش بر ساختار نواری	98
4-5-5- مدلهای سه و چهار نواری	99
4-5-4- چاه های کوانتومی	100
6-4- توليد فوتون	101
1-6-4- عناصر ماتريس گذار	103
4-6-4- پهن شدگی انرژی گذار	104
4-7- تاثیرات کرنش عملکرد لیزر نیمه رسانا	105
4-8- شرایط مرزی	106
1-8-4 شرایط مرزی در شبیه سازی الکتریکی	106
4-8-4 شرایط مرزی در شبیه سازی اپتیکی	106
4-8-4- شرایط مرزی در شبیه سازی حرارتی	107
4-9- پارامترهای مادی	107
4-9-1- تحرک حامل ها	107
4-9-2- ضریب جذب نوار- به نوار	108
4-9-4- ضريب شكست	110
4-9-4- ضريب باز تركيب اوژه	111
4-9-5- افست نواری	111
4-9-4- بازبهنجارش گاف نواری	111
4-9-7 زمان پراکندگی درون نواری	112
4-9-8- طول عمر باز ترکیب ناشی از نا خالصی هاها	112
4-9-9- ضریب رسانندگی حرارتی آئینه های براگ	112

صفحه	عنوان
	فصل پنجم
	شبیه سازی و نتیجه گیری
115	مقدمه
115	1-5 نتايج شبيه سازى
116	1-1-5- موج ايستاده
118	2-1-5- مُد عملكرد
118	5-1-5-طيف بهره و طول موج خروجي
119	4-1-5 – چگالی جریان های تزریقی
119	1-4-15 چگالی جریان تزریقی الکترون ها
121	2-4-1-5 چگالی جریان تزریقی حفره ها
123	5-1-5- تراکم حامل ها در ناحیه فعال
123	1-5-1-5 چگالی الکترون ها
128	2-5-1-5- چگالی حفرہ ھا
132	6-1-5- بازتركيبها
132	1-6-1-5 باز ترکیب القایی
137	2-6-1-5 باز ترکیب اوژه
139	3-6-1-5 باز ترکیب خودبخودی
140	4-6-1-5 باز ترکیب ناشی از ناخالصی ها
142	7-1-5 – آنالیز حرارتی
142	7-1-5 – 1 – توزيع دما
144	7-1-5 – 2 – منابع گرمایش
144	7-1-5 – 2-1 – گرمای ژول
145	7-1-5 – 2-2 – گرمای باز ترکیب
146	5-1-7 – 2-2 – گرمای جذب اپتیکی

صفحه	عنوان
147	5-1-5 – 2-4 – گرمای تابشی
148	5-1-5 – 2-2 – گرمای تامسون
150	6-2-7-1-5 - گرمای پلتیه
151	8-1-5- بهره
153	5-1-5- تغییرات شدت موج اپتیکی در لایه های مختلف قطعه
154	10-1-5- جريان نشتى
157	2-5 بهینه سازی
157	1-2-5 لايه هاى متوقف كننده
162	5-2-2- بهینه سازی آلایش لایه های ساختار
165	5-2-5- بهینه سازی ساختار نواری
167	3-5 نتیجه گیری
169	4-5 پیشنهاد کار برای آینده
171	مرجع ها
181	پيوست

صفحه	عنوان
10	شکل (2-1) دو مثال از محدودیت جانبی جریان لیزر در لیزر نیمه رسانا
14	شكل (2-2 ) ساختار ليزربهره راهنمايي شده
14	شکل ( 2-3 ) دو مثال از ساختار لیزر شاخص راهنمایی شده
16	شکل( 2-4) لیزر نیمه رسانای آرایه ای
17	شکل ( 2-5) (الف ) دیود لیزر گسیل لبه ای معمولی
17	(ب ) دیود لیزر گسیل سطحی با جفت کننده شبکه توری
18	شکل (6-2) نمودار انرژی برحسب مکان در طول محور لیزر آبشاری
	کوانتومی نوع - n
20	شکل (p-2) نمودار تراز انرژی لیزر ژرمانیوم آلائیده شده نوع  -p
	شكل (8-2) آرايش تقويت كننده – نوسان كننده براي ليزر Ge آلائيده
	شکل (2-9) گذارهای تابشی و غیر تابشی در لیزرهای نیمه رسانا (الف) گسیل خودبخودی
21	(ب) گسیل القایی (ج) جذب
2	شكل(2-10) ديود ليزر فابرى- پرو
3	شکل(p-n) پیوندگاه p-n در لیزرهای نیمه رسانا
.3	شکل(2-12) تزریق حامل ها در پیوندگاهp-n تحت بایاس مستقیم
24	شکل (2-13) (الف) انرژی الکترون ها (ب) ضریب شکست برای ساختار ناهمگون دوتایی
26	شکل(2-14) توزیع شدت نوری در موجبر نوری
28	شکل (2-15) نمودار توان نوری برحسب جریان لیزرهای نیمه رسانا
29	شکل(2-16) شدت نورهای داخلی و خارجی لیزر فابری-پرو
Al برای ساختا	شکل (2-17) ضریب محدودیت نوری بر حسب ضخامت لایه فعال به ازای کسرهای مولی مختلف
34	ناهمگون دوتایی Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As/GaAs
34	شکل (2-18) چگالی جریان آستانه برحسب تابعی از ضخامت لایه فعال

صفحه	عنوان
یی از جفت ش	شکل(2-19) (الف) چگالی حامل و (ب) چگالی فوتون ها بر حسب تغییرات چگالی جریان با چشم پوش
36	گسیل خودبخودی به مد لیزر دهی
	شکل(2-2) چگالی حامل و فوتون بر حسب چگالی جریان همراه به جفت شدگی گسیل خودبخودی
37	به مد لیزر دهی
37	شکل(21-2) ) تغییرات توان بر حسب جریان به ازای دماهای مختلف در عملکرد پالسی
38	شكل (22-2) انواع فرآيند باز تركيب اوژه(الف) CHSH (ب) CHCC
39	شکل(23-2) ) فرآیند جذب در (الف) نوار حفره سنگین (ب) تراز پذیرنده
43	شکل(1-3) ساختار یک VCSEL (سمت چپ) و یک لیزر گسیل لبه ای(سمت راست)
45	شکل (VCSEL(2-3 بهره - هدایت شده
46	شكل(VCSEL (3-3 بمباران يونى شده
47	شکلVCSEL (4-3) گسیلنده پایین با Etched-mesa شکل(VCSEL (4-3
48	شکل( 3-5) دو ترکیب ممکن از VCSELهای air-posted
49	شكل (VCSEL (6-3 بمباران-پروتونى
50	شکل (7-3) یک VCSEL را با ساختار ناهمگون دفن شده
50	شکل (VCSEL(8-3 با دریچه اکسیدی
52	در شکل( VCSEL (9-3 با موجبر با موجبر تدریجا باریک شده
53	شکل(3-10) یک پیکربندی ممکن از VCSEL پاد هدایت
53	شکل(3-11) ضریب شکست متناظر در طول جهت عرضی
53	شکل (VCSEL (12-3 با ساختار ناهمگون دفن شده ( سمت چپ) و VCSEL با ساختار
	پيوندگاه تونلی(سمت راست)
54	شكل(VCSEL (13-3 با كاواک خارجی
55	شكل( VCSEL (14-3 با كريستالهاى فوتونى
56	شكل( VCSEL(15-3 با سطح برجسته
ازهای 58	شکل (3-16 میان اتصالات فضای آزاد موازی همراه با آرایه ای از VCSEL ها و آرایه ای از آشکارسا یکپارچه شده با میکرو لنزها

	شکل( 3-17))) طرح پیشنهادی از لینک اطلاعات نوری تسهیم گری تقسیم طول موج همراه با
59	آرایه ای از VCSEL های یکپارچه شده بعنوان فرستنده چند طول موجی
63	شکل (3-18) مشخصه های بازتابندگی DBR های مرکب
65	شکل (3-19) ضرایب رسانندگی حرارتی ترکیبات نیمه رسانای مختلف جور شده بر روی InP
69	شكل VCSEL(20-3) با طول موج خروجى 1550 نانومتر
70	شكل VCSEL(21-3) با طول موج خروجى 1305 نانومتر
71	شکل (3-22) ساختار لایه های نهایی
72	شکل(3-23) نمودار توان و ولتاژ بر حسب جریان به ازای دماهای مختلف عملکرد
72	شكل (3-24) طيف توزيع شدت قطعه
78	شکل (4-1) مکانیزم های اصلی بازترکیب در یک نیمه رسانا
81	شکل (4-2) مکانیزمهای تولید زوج الکترون و حفره در نیمه رساناها
85	شکل (3-4) میدان الکترومغناطیسی عرضی رونده در محور z
87	شکل (4-4) عمق نفوذ و جا بجایی فاز
88	شکل (4-5)موجهای عبوری و بازتابیده در فصل مشترکهای موازی
	شکل ( 4-6) نمایشی از توابع الکترونیکی درون یک کریستال (الف) پتانسیل در طول محور اتمها
95	(ب) توابع موج الكترون آزاد (ج) ضريب دامنه تابع بلاخ با دوره شبكه (د) تابع بلاخ
101	شکل (4-7) ترازهای انرژی، توابع موج ،پاشندگی انرژی و چگالی حالتها در چاههای کوانتومی
103	شکل (4-8) بهره (الف) مواد حجمی (ب) مواد چاه کوانتومی
109	شکل (4-9) انواع مختلف جذب در نوارهای نیمه سانا
	شکل (4-10) طیف PL چاههای کوانتومی خط توپر نشان دهنده اندازه گیریها و خط چین نتایج
111	شبیه سازی
	شکل (5-1) نمودارهای توان -جریان و ولتاژ -جریان تئوری (خط چین) و تجربی(خط) در دما های
115	زمينه مختلف
116	شکل (5-2) شکل طرح موج ایستاده و موقعیت چاه های کوانتومی نسبت به آن
117	شکل (3-5) ساختار نواری قطعه نزدیک جریان آستانه در دمای $ m 20^{\circ}C$
117	شكل (4-5) شكل موج ايستاده و موقعيت پيوندگاه تونلي نسبت به آن

صفح	عنوان
	شکل (5-5) توزیع دو بعدی شدت نور سطحی (خطوط پر مایل) نیمی از قطعه بر حسب ابعاد آن
118	در دمای محیط 20°C
119	شکل (5-6) طیف بهره ناحیه فعال بر حسب طول موج (در شکل طول موج کاواک نیز مشخص شده است)
	شکل (5-7) توزیع چگالی جریان طولی الکترون ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان آستانه و
	دمای محیط $^\circ\mathrm{C}$ 20 دنگ های مختلف نشان دهنده چگالی جریان خاصی هستند که با توجه به نمونه
119	کنار شکل تغییر می کنند
120	شکل (5-8) توزیع چگالی جریان قائم الکترون ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان آستانه و دمای محیط C ° C
	شکل (5-9) توزیع چگالی جریان طولی الکترون ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر
120	و دمای محیط C °C و دمای محیط C
	شکل (5-10) توزیع چگالی جریان قائم الکترون ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و
121	دمای محیط C ° C دمای محیط C
121	شکل (5-11) توزیع چگالی جریان طولی حفره ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان آستانه و دمای محیط C °C
	شکل (5-12) توزیع چگالی جریان قائم حفره ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان آستانه و
122	دمای محیط C ° C دمای محیط C
	شکل (5-13) توزیع چگالی جریان طولی حفره ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و
122	دمای محیط C °C
	شکل (5- 14) توزیع چگالی جریان قائم حفره ها بر حسب ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و
123	دمای محیط C °C دمای محیط C
	شکل (5- 15) توزیع دو بعدی تراکم الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
124	ابعاد قطعه نزدیک به جریان آستانه و دمای محیط C ° C
	شکل (5- 16) توزیع سه بعدی تراکم الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب ابعاد قطعه
124	نزدیک به جریان آستانه و دمای محیط $^\circ\mathrm{C}$ 20
	شکل (5- 17) توزیع دو بعدی تراکم الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب ابعاد قطعه
125	در جریان 6 میلی آمیر و دمای محیط C °C

شکل (5- 18) توزیع سه بعدی تراکم الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C °C 126
شکل (5- 19) اندازه چگالی جریان کلی عبوری از ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C ° C 127
شکل (5-20) توزیع سه بعدی تراکم الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط $^{\circ}\mathrm{C}$ 60 ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط $^{\circ}\mathrm{C}$
شکل (5-21) جریان عبوری کلی از قطعه بر حسب ارتفاع و شعاع آن
(پیکان های موجود در شکل نشان دهنده چگونگی عبور جریان تزریقی در قطعه هستند)
شکل (5-22) تغییر چگالی حفره ها بر حسب ارتفاع قطعه نزدیک به محور لیزر (قسمت های مرکزی)
شکل (5-23) توزیع دو بعدی تراکم حفره ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه نزدیک به جریان آستانه و دمای محیط C °C 129
شکل (5-24) توزیع سه بعدی تراکم حفره ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه نزدیک به جریان آستانه و دمای محیط $^\circ  m C$ 20
شکل (5-25) چگالی دو بعدی حفره ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C° 20
شکل (5-26)چگالی سه بعدی حفره ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C° 20
شکل (5-27) تراکم و چگالی جریان حفره ها بر حسب شعاع قطعه در آخرین چاه کوانتومی
شکل (5-28) چگالی سه بعدی حفره ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C° 60
شکل(5-29) آهنگ گسیل القایی در چاه های کوانتومی بر حسب
ابعاد قطعه نزدیک به آستانه و دمای C °C استانه و دمای C
شکل (5-30) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
ابعاد قطعه نزدیک در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C° 20

صفحه	عنوان
	شکل (5-31) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
134	ابعاد قطعه نزدیک به آستانه و دمای محیط °C° 60
	شکل (5-32) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
135	ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط °C 60
	شکل (5-33) بهره مدی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
135	ابعاد قطعه در جریان آستانه و دمای محیط C°C
	شکل (5-34) بهره مدی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب ابعاد
136	قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط $^\circ\mathrm{C}$ 20
	شکل (5-35) بهره مدی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
137	ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C ° 60
	شکل(5-36) آهنگ باز ترکیب اوژه در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
137	ابعاد قطعه در جریان آستانه و دمای محیط C°C 20°C
	شکل(5-37) آهنگ باز ترکیب اوژه در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
138	ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C °C
	شکل (5-38) آهنگ بازتر کیب اوژه در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب ابعاد قطعه
139	در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C °60
	شکل (5-39) آهنگ بازترکیب خودبخودی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
139	ابعاد قطعه در جریان آستانه و دمای محیط C °C
	شکل (5-40) آهنگ باز ترکیب خودبخودی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
140	ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و دمای محیط C °C
	شکل (5-41) آهنگ باز ترکیب خودبخودی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب ابعاد
141	قطعه در جریان 6 میلی آمپر و در دمای محیط C °C
	شکل (42-5) آهنگ باز ترکیب ناشی از ناخالصی ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب ا
141	بعاد قطعه در جریان آستانه و دمای محیط C °C
	شکل (43-5) آهنگ باز ترکیب ناشی از ناخالصی ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) بر حسب
141	ابعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و در دمای محیط C °C

مکل(5-44) آهنگ باز ترکیب ناشی از ناخالصی ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برحسب	
بعاد قطعه در جریان 6 میلی آمپر و در دمای محیط C ° 00	143
	143
	144
لمکل(5-47) توان گرمایی بر حسب ارتفاع قطعه در بیشینه توان (جریان 6 میلی آمپر)	145
ىكل (5-48) گرماى ژول بر حسب ابعاد قطعه در جريان آستانه (1/7 ميلى آمپر)	145
ىكل (5-49) گرماى ژول بر حسب ابعاد قطعه در توان بيشينه (جريان 6 ميلى آمپر)	145
مکل (50-5) گرمای بازترکیب در چاه های کوانتومی بر حسب ابعاد	
قطعه در جریان آستانه (1/7 میلی آمپر)	146
یکل (51-5) گرمای بازترکیب در چاه های کوانتومی بر حسب	
عاد قطعه در توان بیشینه (جریان 6 میلی آمپر )	146
مکل (52-5) گرمای جذب اپتیکی در چاه های کوانتومی بر حسب بعاد قطعه در جریان آستانه (1/7 میلی آمپر)	147
مکل (53-5) گرمای جذب اپتیکی در چاه های کوانتومی بر حسب ابعاد	
فطعه در توان بیشینه (جریان 6 میلی آمپر)	147
یکل (54-5) گرمای تابشی در چاه های کوانتومی بر حسب	
بعاد قطعه در جریان آستانه (1/7 میلی آمپر)	148
یکل (5-55) گرمای تابشی در چاه های کوانتومی بر حسب	
بعاد قطعه در توان بیشینه (جریان 6 میلی آمپر)	148
مکل (56-5) گرمای تامسون در چاه های کوانتومی بر حسب ابعاد فطعه در جریان آستانه (1/7 میلی آمپر)	149
مکل (57-5) گرمای تامسون در چاه های کوانتومی بر حسب ابعاد	
فطعه در توان بیشینه (جریان 6 میلی آمپر)	149
ىكل(5-58) گرماى پلتيه بر حسب ابعاد قطعه در جريان آستانه (1/7 ميلى آمپر)	50

	شکل (5-60) طیف بهره ناحیه فعال در دمای محیط $\mathrm{C}~20^\circ$ با تراکم
151	حامل های مختلف ( تغییرات تراکم برای هر نمودار از پایین به بالا % 0.66 است)
	شکل (61-5) طیف بهره ناحیه فعال در دمای محیط C ° 60 با تراکم
151	حامل های مختلف ( تغییرات تراکم از پایین به بالا ٪ 0.66 است)
152	شکل (5-62) پیک بهره ناحیه فعال بر حسب چگالی حامل در دما های محیط مختلف
152	شکل (5-63) پیک بهره ناحیه فعال بر حسب چگالی جریان در دما های محیط مختلف
153	شکل (5-64) زیر نوار های انرژی ظرفیت چاه های کوانتومی
153	شکل (5-65) شدت موج اپتیکی بهنجار شده در دو بعد
154	شکل (5-66) شدت موج اپتیکی بهنجار شده در سه ب <b>ع</b> د
154	شكل(5-67) تزريق و نشت حامل ها
	شکل (5-68) شکل (5-68) چگالی جریان قائم الکترون ها و حفره ها بر حسب
155	ارتفاع قطعه در دمای محیط $^{\circ}\mathrm{C}$ ارتفاع قطعه در دمای محیط $^{\circ}\mathrm{C}$
	شکل (5-69) چگالی الکترون ها در ناحیه فعال (چا های کوانتومی) در جریان آستانه ( خط پر)
156	و جريان 6 ميلي آمپر (خط چين)
156	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در
156	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 60 (خط توپر)
156 156 157	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 60 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AlInAs)
156 156 157	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 60 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AlInAs) شکل (5-72) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های
156 156 157 158	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 60 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AlInAs) شکل (5-72) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده.
156 156 157 158	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 60 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AIInAs) شکل (5-72) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده
156 156 157 158 158	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C °20(خط چین) و C °60 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AlInAs) شکل (5-72) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-73) چگالی الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده.
156 156 157 158 158	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 06 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AIInAs) شکل (5-27) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-73) چگالی الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-71) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های
156 156 157 158 158 158	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 2(خط چین) و C ° 06 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AIInAs) شکل (5-27) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-37) چگالی الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-47) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده
156 156 157 158 158 158	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 00 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AIInAs) شکل (5-27) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-27) چگالی الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-27) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-27) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-27) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده
156 156 157 158 158 159 159	و جریان 6 میلی آمپر (خط چین) شکل (5-70) چگالی جریان قائم الکترون ها در جریان آستانه و6 میلی آمپر در دماهای محیط C ° 20(خط چین) و C ° 60 (خط توپر) شکل (5-71) ساختار نواری با لایه متوقف کننده (AlInAs) شکل (5-27) نمودار های توان - جریان شبیه سازی شده برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-71) چگالی الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-77) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده شکل (5-77) آهنگ گسیل القایی در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) برای ضخامت های مختلف لایه متوقف کننده مختلف لایه متوقف کننده

کا (77-5) جگال الکترمن هادریانی و الوقای کوانترو و دادهای کوانترو و الوقای دادهای در ۲۳-5
میں رہ ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
محتك لايه متوقف دننده
ىنوانصفح
ىكل (5-78) آهنگ گسيل القايى در ناحيه فعال (چاه هاى كوانتومى) براى
فست های مختلف لایه متوقف کننده۵
.کل (5-79) آهنگ باز تر کیب اوژه در ناحیه ف <b>ع</b> ال (چاه های کوانتومی) برای
فست های مختلف لایه متوقف کننده
ىكل (5-80) نمودارهاى توان- جريان براى آلايش هاى( <sup>3 -</sup> 10 <sup>17</sup> cm×) مختلف لايه متوقف كننده
ىكل(5-81) نمودارهاى توان- جريان براى افزايش آلايش ( <sup>3 -</sup> 10 <sup>18</sup> cm) لايه تماس
یکل (5-82) نمودارهای توان- جریان شبیه سازی شده با آلایشهای ( <sup>3 -</sup> m <sup>-10</sup> ×) مختلف
وع n پيوندگاه تونلى
ىكل(5-83) نمودارهاى توان- جريان شبيه سازى شده با آلايشهاى (3 <sup>- cm</sup> 10 <sup>20</sup> ×) مختلف
وع p پيوندگاه تونلى
.کل(5-84) نمودار توان جریان با تمام بهینه سازیهای مطرح شده (نقطه چین نتیجه شبیه سازی)
.کل (5-85) چگالی الکترونها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی) ابرای ساختار بهینه شده
نقطه حین ) و ساختار ابتدایی (خط د )
یکا   (5-86) آهنگ بازتر کین القابر در ناجیه فعال (جاه های کمانتمیر )   برای ساختار بمینه شده
- من ( ) ما اختار التدار (خمار م) (
رفطط چین و ماجنار ابندایی (خط پر)
مکل (5-17) آهنگ بارتر کیب آوره در ناخیه فعال (چاه های توانسومی) ۲ برای ساختار بهینه شده ( نقطه چین ) ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ -
و ساختار ابتدایی (خط پر)
یکل (5-88) چگالی جریان قائم الکترونی در ساختاری با GRIN– SCH خطی
(خط چین) وSCH (خط تو پر)
مکل (5-89) نمودارهای توان- جریان با GRIN– SCH خطی (خط تو پر) و با SCH (خط چین)
.کل (5-90)  چگالی الکترون ها در ناحیه فعال (چاه های کوانتومی)  در ساختارهایی
ا GRIN− SCH خطی(خط توپر) و SCH (خط چین)
لكل (5-91) آهنگ باز تركيب القايي ناحيه فعال (چاه هاي كوانتومي) ساختارهايي
GRIN– SCH خطى (خط چين) و SCH ( خط توير)